

МТКИ-1800-17



www.elvpr.ru

СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

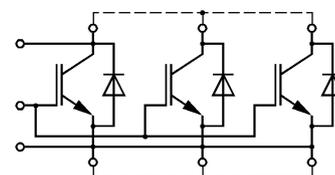
- ◆ одиночный ключ
- ◆ встроенный быстродействующий диод обратного тока
- ◆ корпус с изолированным основанием
- ◆ диагностический вывод коллектора для контроля V_{CE}

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ преобразователи частоты
- ◆ источники бесперебойного питания
- ◆ сварочное оборудование
- ◆ ПСН подвижного состава железных дорог

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ◆ $V_{CES} = 1700 \text{ В}$
- ◆ $I_C = 3600 \text{ А}$ ($T_C = 25 \text{ °C}$)
- ◆ $V_{CEsat} = 2.6 \text{ В}$ (тип.)
- ◆ $I_C = 1800 \text{ А}$ ($T_C = 80 \text{ °C}$)



МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CES}	1700	В
Напряжение затвор-эмиттер	V_{GES}	± 20	
Постоянный ток коллектора	I_C	при $T_C = 25 \text{ °C}$	А
		при $T_C = 80 \text{ °C}$	
Импульсный ток коллектора ($t_p=1\text{мс}$, $T_C = 80 \text{ °C}$)	I_{Cpuls}	3600	А
Постоянный прямой ток диода обратного тока	I_F	1800	
Повторяющийся импульсный прямой ток диода обратного тока	I_{FRM}	3600	
Параметр I^2t для диода обратного тока ($V_R = 0 \text{ В}$, $t_p = 10 \text{ мс}$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	I^2t	980	кА ² с
Суммарная мощность рассеивания ($T_C = 25 \text{ °C}$), IGBT	P_{tot}	13900	Вт
Максимальная температура перехода	T_j	+ 150	°C
Температура хранения	T_{stg}	- 40...+ 125	
Напряжение изоляции ($t = 1 \text{ мин.}$)	V_{isol}	4000	В (эфф)

МТКИ-1800-17

ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT	R_{thjc}	≤ 0.009	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока	R_{thjcD}	≤ 0.017	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1 \text{ Вт/м} \cdot \text{°C}$, на модуль (типичное значение)	R_{thck}	0.004	°C/Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	
Статические характеристики					
Пороговое напряжение затвор-эмиттер ($V_{GE} = V_{CE}$, $I_C = 120 \text{ мА}$)	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($V_{GE} = 15 \text{ В}$, $I_C = 1800 \text{ А}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_{CEsat}	- -	2.6 3.1	3.1 3.6	
Ток утечки коллектор-эмиттер ($V_{CE} = 1700 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	I_{CES}	- -	0.05 25	3.6 180	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ($V_{GE} = 20 \text{ В}$, $V_{CE} = 0 \text{ В}$)	I_{GES}	-	-	400	нА
Характеристики на переменном токе					
Заряд затвора ($V_{GE} = -15 \dots +15 \text{ В}$)	Q_G	-	22	-	мкКл
Входная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{ies}	-	118	-	нФ
Обратная переходная емкость ($V_{CE} = 25 \text{ В}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$, $f = 1 \text{ МГц}$)	C_{res}	-	6.0	-	
Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125 \text{ °C}$)					
Время задержки включения ($V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 1800 \text{ А}$, $R_G = 0.8 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(on)}$	- -	0.3 0.3	- -	мкс
Время нарастания ($V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 1800 \text{ А}$, $R_G = 0.8 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_r	- -	0.2 0.2	- -	

МТКИ-1800-17

Время задержки выключения ($V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 1300 \text{ А}$, $R_G = 0.8 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(off)}$	-	1.3	-	мкс
		-	1.3	-	
Время спада ($V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 1800 \text{ А}$, $R_G = 0.8 \text{ Ом}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	t_f	-	0.15	-	мкс
		-	0.16	-	
Энергия потерь при включении ($V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 1800 \text{ А}$, $R_G = 0.8 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ °C}$, $L_S = 50 \text{ нГн}$, за один импульс)	E_{on}	-	570	-	мДж
Энергия потерь при выключении ($V_{CC} = 900 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $I_C = 1800 \text{ А}$, $R_G = 0.8 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ °C}$, $L_S = 50 \text{ нГн}$, за один импульс)	E_{off}	-	725	-	
Ток короткого замыкания ($t_p \leq 10 \text{ мкс}$, $V_{CC} = 1000 \text{ В}$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$, $V_{CEmax} = V_{CES} -$ $L_{\sigma(CE)} \times di/dt$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	I_{sc}	-	7200	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	12	-	нГн

Характеристики диода обратного тока

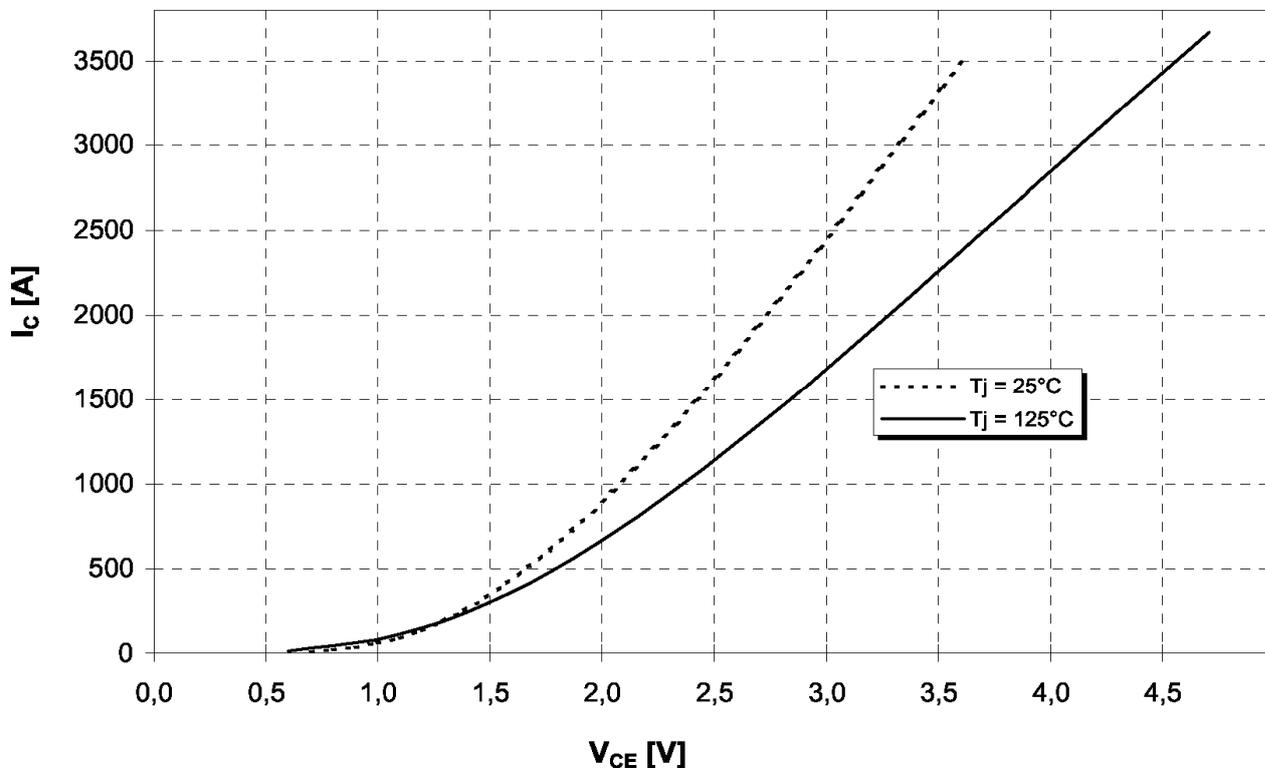
Прямое падение напряжения ($I_F = 1800 \text{ А}$, $V_{GE} = 0 \text{ В}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	V_F	-	2.1	2.5	В
		-	1.95	2.3	
Ток обратного восстановления ($I_F = 1800 \text{ А}$, $V_{GE} = -10 \text{ В}$, $V_R = 900 \text{ В}$, $di_F/dt = -10800 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	I_{rr}	-	1050	-	А
		-	1500	-	
Время обратного восстановления ($I_F = 1800 \text{ А}$, $V_{GE} = -10 \text{ В}$, $V_R = 900 \text{ В}$, $di_F/dt = -10800 \text{ А/мкс}$, $T_j = 125 \text{ °C}$)	t_{rr}	-	0.69	-	мкс
Заряд обратного восстановления ($I_F = 1800 \text{ А}$, $V_{GE} = -10 \text{ В}$, $V_R = 900 \text{ В}$, $di_F/dt = -10800 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	Q_{rr}	-	240	-	мкКл
		-	520	-	
Энергия потерь при обратном восстановлении ($I_F = 1800 \text{ А}$, $V_{GE} = -10 \text{ В}$, $V_R = 900 \text{ В}$, $di_F/dt = -10800 \text{ А/мкс}$) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	E_{rec}	-	130	-	мДж
		-	260	-	

МТКИ-1800-17

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

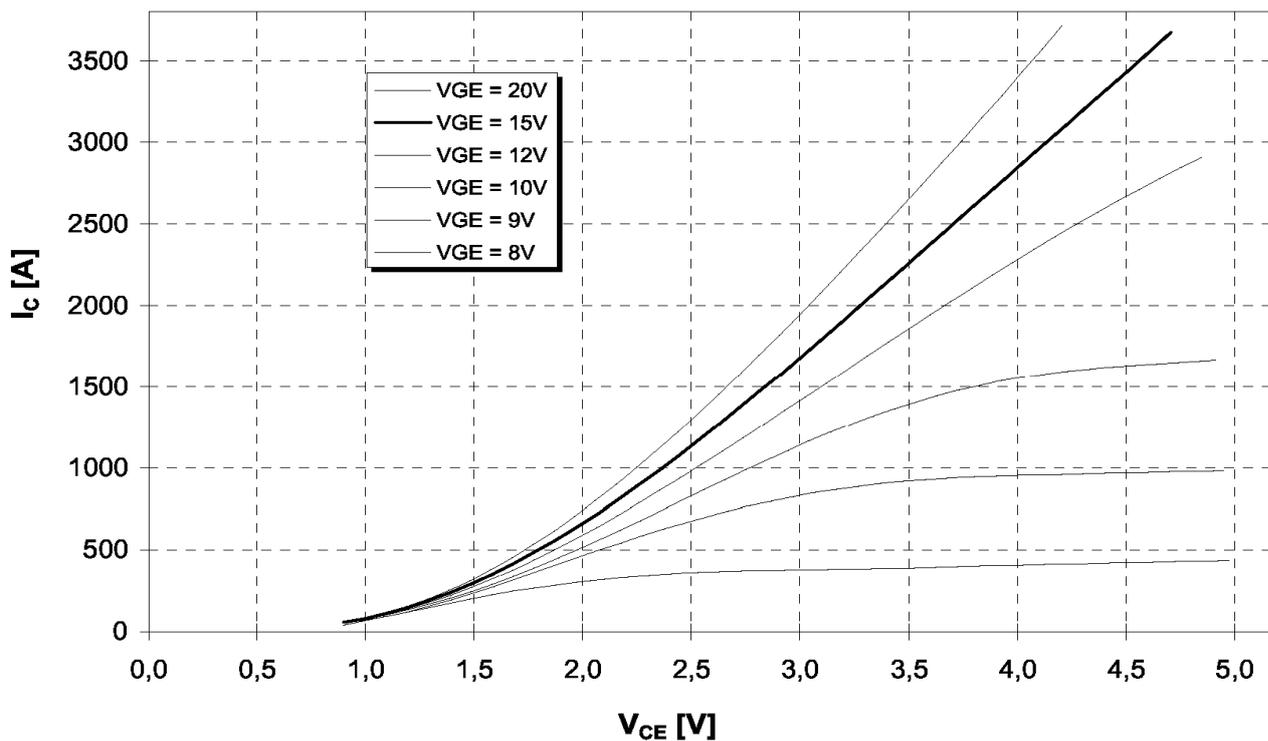
Режим измерения: $V_{GE} = +15 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$



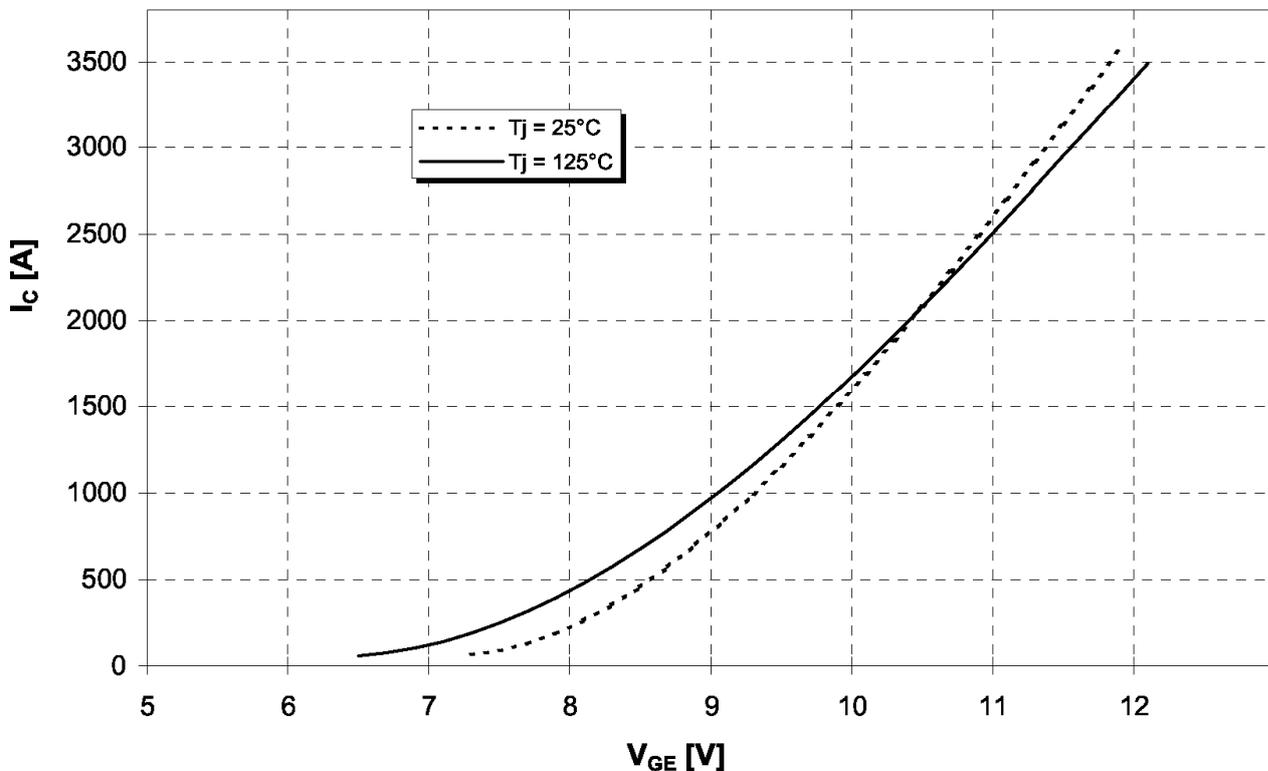


МТКИ-1800-17

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

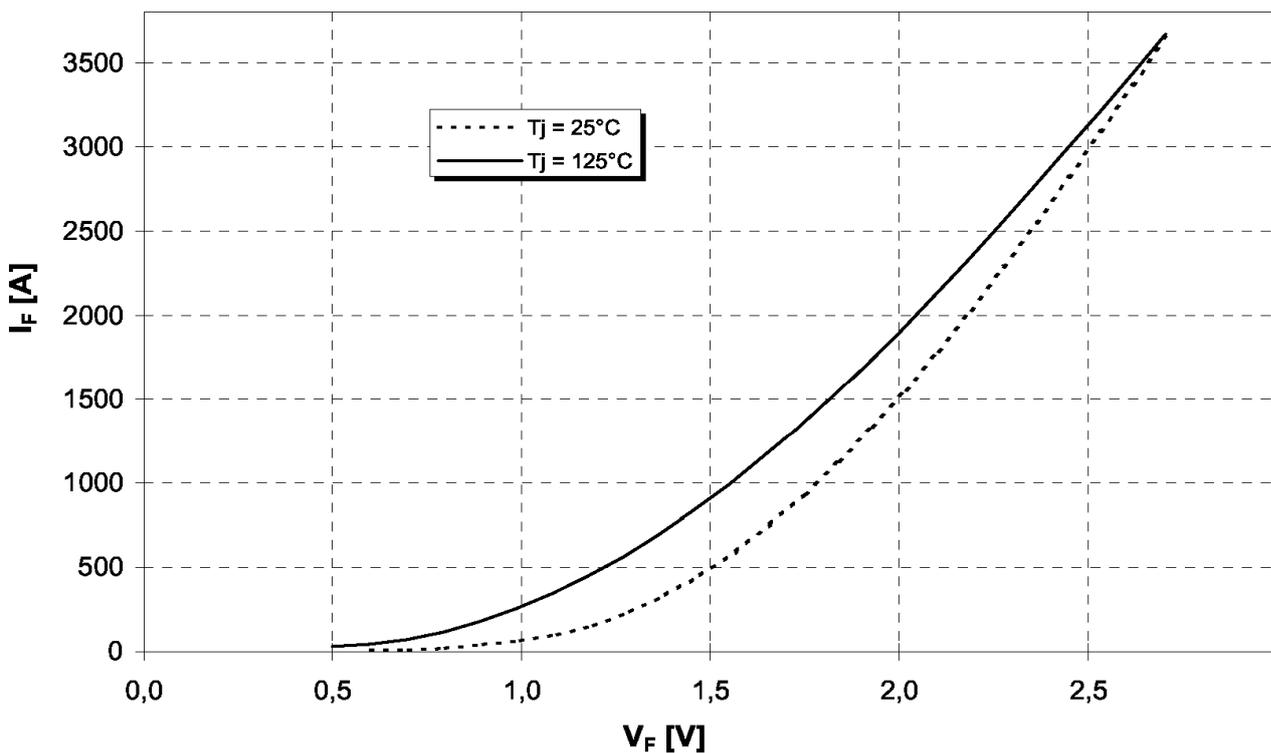
Режим измерения: $V_{CE} = 20 \text{ В}$, $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые прямые характеристики диода обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$

Режим измерения: $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$

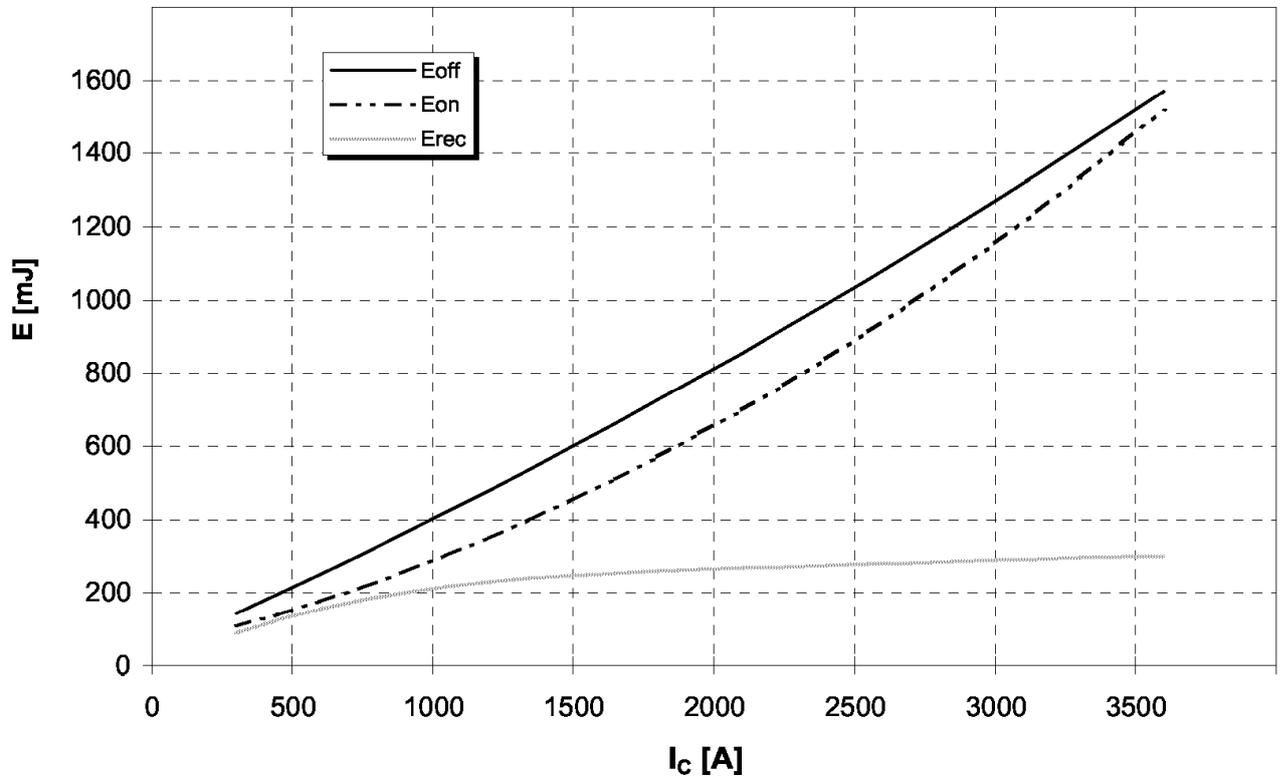


МТКИ-1800-17

Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$, индуктивная нагрузка

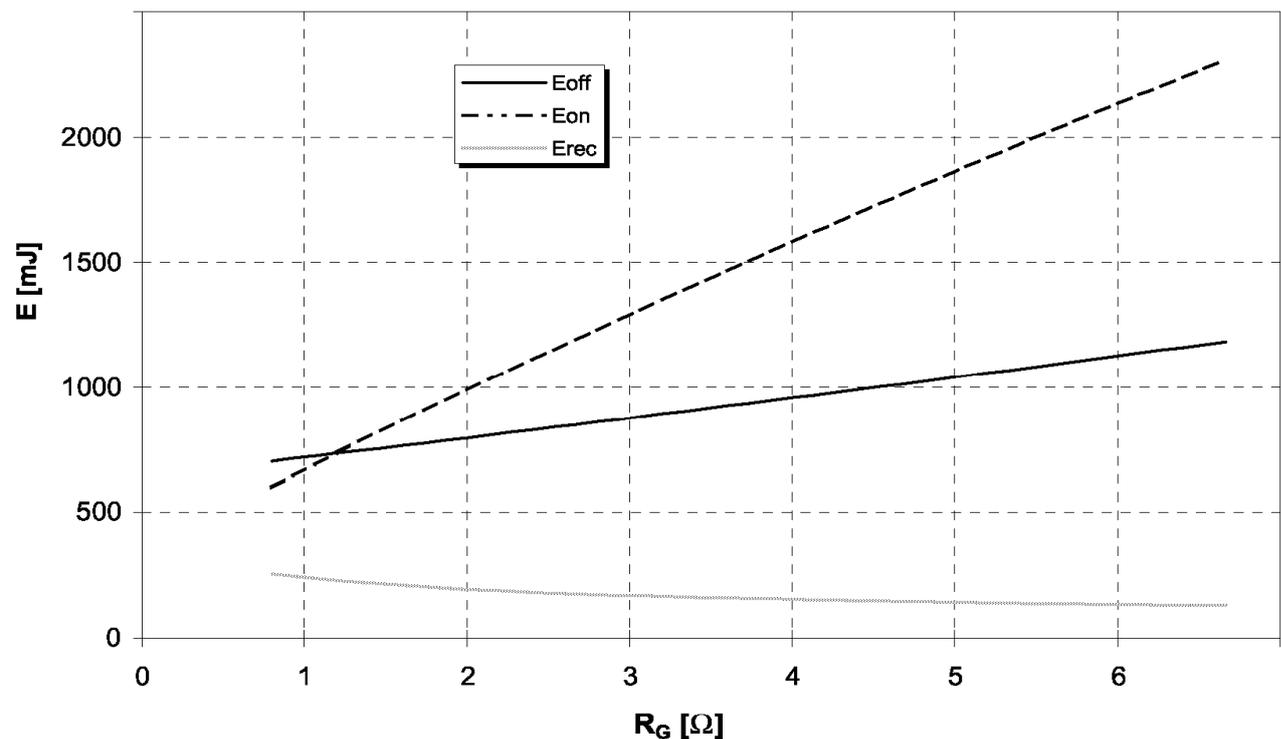
Режим измерения: $V_{CE} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $R_G = 0.8$ Ом, $T_j = 125$ °С



Типовые зависимости коммутационных потерь

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$, индуктивная нагрузка

Режим измерения: $I_C = 1800$ А, $V_{GE} = \pm 15$ В, $T_j = 125$ °С

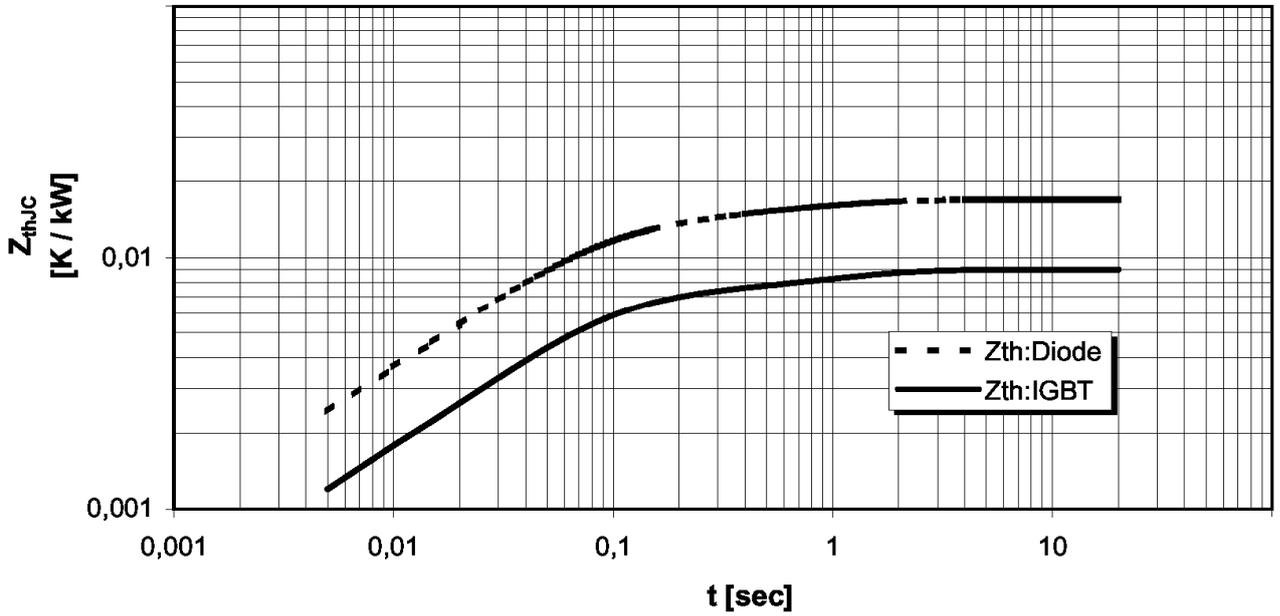




МТКИ-1800-17

Переходное тепловое сопротивление

$$Z_{thjc} = f(t_p)$$



Обратная область безопасной работы IGBT

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения: $R_G = 0.8 \text{ Ом}$, $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$

